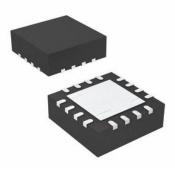
# 低压三个半桥驱动器

### 产品简述

MS39233 是一款低压三个半桥驱动器。它可应用于低电压及电池供电的运动控制场合。并且内置电荷泵来提供内部功率 NMOS 所需的栅驱动电压。

MS39233 可以提供最高 2.8A 的峰值电流,其功率电源供电范围 从 1.8V 到 10V,模拟电源供电范围从 1.8V 到 6V。

半桥由 EN/IN 逻辑控制,并且当所有的 ENx=0V 超过 3ms 时,进入待机模式。



QFN16

#### 主要特点

- 三个半桥驱动器,低输出导通电阻,420mΩ(HS+LS)
- 2.8A 峰值电流能力
- 功率电源供电范围: 1.8V 到 10V
- 模拟电源供电范围: 1.8V 到 6V
- 独立 EN/IN 半桥控制逻辑
- 待机模式下,功耗不超过 120nA@VS<6V
- QFN16L 封装(背部散热片),3mmx3mm
- 保护功能:欠压保护、过流保护、短路保护以及过温保护

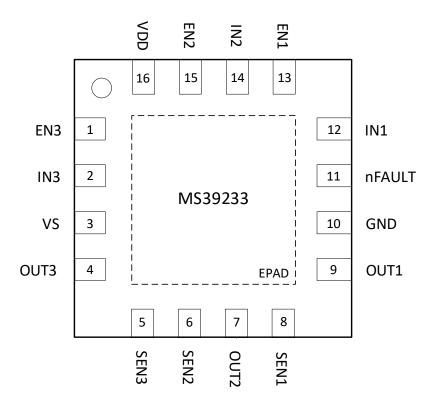
#### 应用

- 电池供电,三相无刷电机(BLDC)
- 玩具
- 机器人
- 便携式医疗电子设备

### 产品规格分类

产品	封装形式	丝印名称
MS39233	QFN16	MS39233

# 管脚图

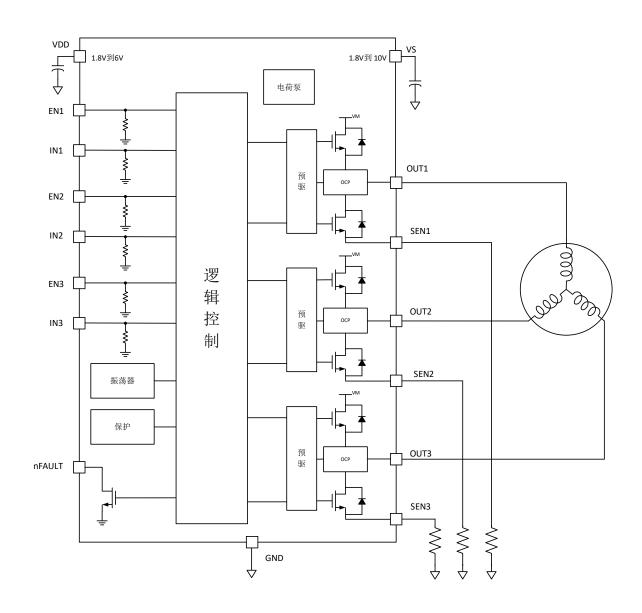




# 管脚说明

管脚编号	管脚名称	管脚属性	管脚描述
1	EN3	I	OUT3 使能控制
2	IN3	I	OUT3 驱动控制
3	VS	-	功率电源
4	OUT3	0	OUT3 输出
5	SEN3	10	OUT3 低边功率管源端,可接 SENSE 电阻
6	SEN2	10	OUT2 低边功率管源端,可接 SENSE 电阻
7	OUT2	0	OUT2 输出
8	SEN1	10	OUT1 低边功率管源端,可接 SENSE 电阻
9	OUT1	0	OUT1 输出
10	GND	-	地
11	nFAULT	0	错误输出脚
12	IN1	I	OUT1 驱动控制
13	EN1	I	OUT1 使能控制
14	IN2	I	OUT2 驱动控制
15	EN2	I	OUT2 使能控制
16	VDD	-	模拟电路电源
-	EPAD	-	散热片,必须接地

# 内部框图



# 极限参数

芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作 状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在 此极限条件下。

参数	符号	额定值	单位
功率电源电压	VS	-0.3 ~ 15	V
低压电源电压	VDD	-0.3 ~ 6	V
过流保护值	IOCP	4	А
工作温度范围	TJ	-40 ~ 125	°C
储存温度范围	Tstg	-40 ~ 150	°C
SENX 电压		< 0.6	V
逻辑输入电压	VIN	5.5	V
ESD	НВМ	±6k	٧

# 推荐工作条件

### 工作电源电压范围

		参数 范围			
参数	符号	最小	标准	最大	单位
功率电源电压范围	VS	1.8		10	V
模拟电源电压范围	VDD	1.8		6	V

# 电气参数

VS=5V, VDD=3.3V。注意:没有特别规定,环境温度为Ta = 25℃±2℃。

### 电流功耗

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VS 待机电流	lvSstandby	EN1=EN2=EN3=0V 持续时间超过 3ms			0.1	μΑ
	I <sub>VS1</sub>	ENx=1		140		μΑ
VS 工作电流	I <sub>VS2</sub>	50kHz PWM		380		μΑ
VDD 待机电流	IVDDstandby	EN1=EN2=EN3=0V 持续时间超过 3ms			0.01	μΑ
	I <sub>VDD1</sub>	ENx=1		390		μΑ
VDD 工作电流	I <sub>VDD2</sub>	50kHz PWM		430		μΑ
待机检测时间	td <sub>standby</sub>	EN1=EN2=EN3=0V		3		ms

## 数字输入输出

200 1 July 7 July 111						
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
高电平输入	V <sub>in(H)</sub>	VDD=3.3V	1.7			V
低电平输入	V <sub>in(L)</sub>	VDD=3.3V			1.2	V
输入迟滞	V <sub>in(hys)</sub>	VDD=3.3V		0.4		V
下拉电阻	R <sub>pd</sub>			270		kΩ
PWM 频率	f <sub>pwm</sub>			250		kHz

## 输出功率管

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
上管导通电阻	$R_{dsh}$	VS=5V,lout=500mA		210		mΩ
下管导通电阻	R <sub>dsl</sub>	VS=5V,lout=500mA		210		mΩ
输出关闭漏电流	I <sub>leak</sub>	ENx=0, OUTx 接 VS 或 GND	-1		1	μΑ



## 保护电路

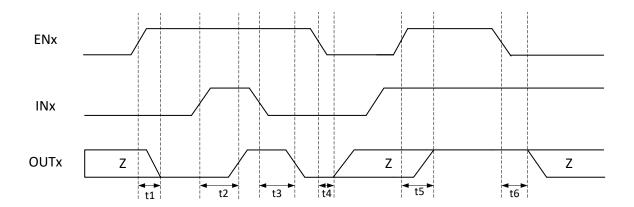
参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD 欠压保护		VDD 上升		1.7		V
VDD 欠压保护		VDD 下降		1.6		V
过流保护	l <sub>ocp</sub>			4		А
过流保护检测时间	t <sub>ocp_d</sub>			2		μs
过流保护自启动关闭时间	t <sub>ocp_r</sub>			2.8		ms
		温度上升		165		°C
过温保护	T <sub>otpl</sub>	温度下降		137		°C
过温保护迟滞	Totphys			28		°C

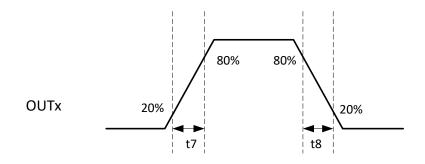
# 时序

## VS=5V, VDD=3.3V, 输出空载

符号	测试条件	最小值	最大值	单位
t1	IN=0,EN 从 0 变到 1,输出从 Z 态变低延时		200	ns
t2	EN=1,IN 从 0 变到 1,输出从低变高延时		200	ns
t3	EN=1,IN 从 0 变到 1,输出从高变低延时		200	ns
t4	IN=0,EN 从 1 变到 0,输出从低变 Z 态延时		200	ns
t5	IN=1,EN 从 0 变到 1,输出从 Z 态变高延时		200	ns
t6	IN=1,EN 从 1 变到 0,输出从高变 Z 态延时		200	ns
t7	输出上升沿时间		200	ns
t8	输出下降沿时间		160	ns







## 功能描述

MS39233 是一款低压三个半桥驱动器,可以用来驱动一个无刷电机。

#### 半桥控制逻辑

MS39233 采用 EN/IN 逻辑控制半桥。每个半桥独立控制。

#### 其真值表如下:

ENx	INx	OUTx	半桥状态
0	Х	Z	关闭
1	0	L	下管打开
1	1	Н	上管打开

#### 待机模式

MS39233 提供待机模式,当 EN1=EN2=EN3=0 的时间超过 3ms 时,芯片将进入待机模式。待机模式下,芯片所有模块都会被关闭。若 ENx 中有一个脚被拉高,芯片将从待机模式进入正常工作模式。

### 电源供电及输入管脚

VDD 和 VS 可以不按照顺序上电或者下电。当 VDD 下电后,芯片会进入低功耗状态,此时 VS 只消耗很小的电流。如果 VS 电压在 1.8V 到 6V 之间,可以从外部将 VDD 和 VS 接一起进行供电。

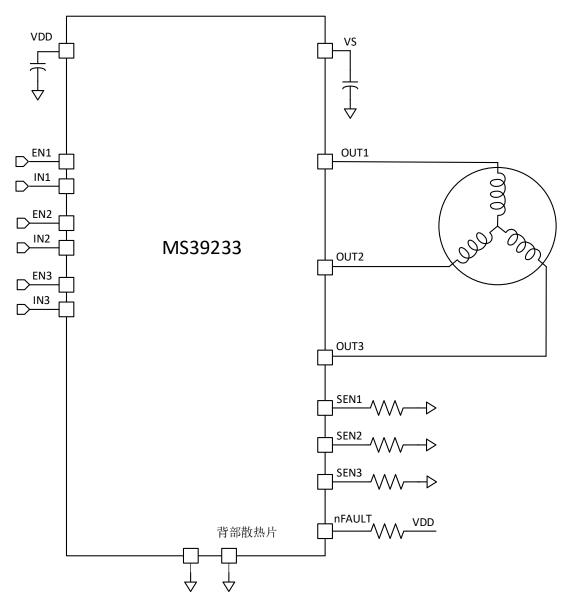
#### 保护电路

MS39233 提供完备的保护电路,包括欠压保护、过流保护、过温保护等。

MS39233 针对每个功率 MOS 做了独立的过流保护:包括对电源、对地以及输出间短路。当触发过流保护时,芯片会关闭输出 2.8ms 左右,再重新开启,确保芯片不会因过流而损坏。

在异常状态时, nFAULT 脚会被拉低。

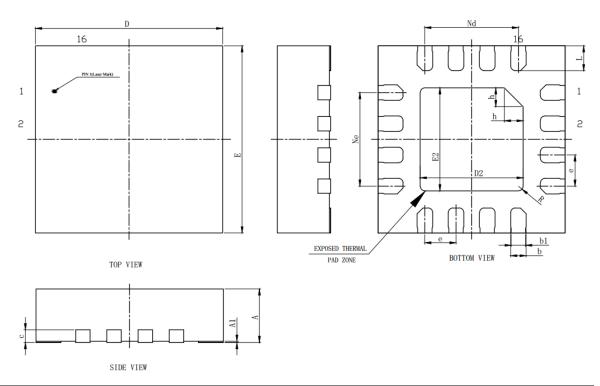
# 典型应用图



注意: MS39233 具有背部散热片,应用时必须接地。

# 封装外形图

# QFN16L (03X03) (背部带散热片)



hele [7]	尺寸 (毫米)					
符号	最小	典型	最大			
А	0.80	0.85	0.90			
A1	0	0.02	0.05			
b	0.20	0.25	0.30			
b1		0.23REF				
С	0.203REF					
D	2.90	3.00	3.10			
D2	1.60	1.65	1.70			
e		0.50BSC				
Nd		1.50BSC				
Ne		1.50BSC				
Е	2.90	3.00	3.10			
E2	1.60	1.65	1.70			
L	0.35	0.40	0.45			
h	0.25	0.30	0.35			
R	0.075REF					

# 印章与包装规范

1. 印章内容介绍



MS39233 XXXXXXX

产品型号: MS39233 生产批号: XXXXXXX

2. 印章规范要求

采用激光打印,整体居中且采用 Arial 字体。

3. 包装规范说明

型号	封装形式	只/卷	卷/盒	只/盒	盒/箱	只/箱
MS39233	QFN16	4000	1	4000	8	32000



### 声明

- 瑞盟保留说明书的更改权,恕不另行通知!客户在下单前应获取最新版本资料,并验证相关信息 是否完整。
- 在使用瑞盟产品进行系统设计和整机制造时,买方有责任遵守安全标准并采取相应的安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成的人身伤害或财产损失!
- 产品提升永无止境,本公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!





### MOS电路操作注意事项

静电在很多地方都会产生,采取下面的预防措施,可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电的影响而引起的损坏:

- 1、操作人员要通过防静电腕带接地。
- 2、设备外壳必须接地。
- 3、装配过程中使用的工具必须接地。
- 4、必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。



+86-571-89966911



杭州市滨江区伟业路 1 号 高新软件园 9 号楼 701 室



http://www.relmon.com